DERWENT-ACC-NO:

2000-189413

DERWENT-WEEK:

200017

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Spinner washing apparatus for cleaning semiconductor wafer, has injection device which injects wash water to processed object held on rotating spinner table

•

PATENT-ASSIGNEE: DISCO KK[DISCN]

PRIORITY-DATA: 1998JP-0204830 (July 21, 1998)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

B08B 003/02

JP 2000033346 A February 2, 2000 N/A 005

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP2000033346A N/A 1998JP-0204830 July 21, 1998

INT-CL (IPC): B08B003/02, B08B011/02, H01L021/301, H01L021/304

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000033346A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - An injection device (22) injects wash water to processed object fixed on rotating spinner table (21). The injection device is connected to earth, to remove static current occurring while rubbing injection device and water on processed object.

USE - For cleaning waste adhered to semiconductor wafer after dicing operation.

ADVANTAGE - Static current occurred while rubbing injection device and processed object is prevented, by earthing provided on injection device. Electrification on cleaned object, causing reduction of its quality is eliminated. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the perspective

diagram of spinner washing machine. (21) Spinner table; (22) Injection device.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/3

TITLE-TERMS: SPIN WASHING APPARATUS CLEAN SEMICONDUCTOR WAFER INJECTION DEVICE

INJECTION WASHING WATER PROCESS OBJECT HELD ROTATING SPIN TABLE

DERWENT-CLASS: P43 U11

EPI-CODES: U11-C06A1A; U11-C06A2;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2000-140836

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-33346

(P2000-33346A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		ΡI				テーマコード(参考)
B08B	3/02			B081	3 3/02		В	3B116
	11/02				11/02			3 B 2 O 1
H01L	21/304	643		H011	21/304		643C	
							643A	
		646					646	
			審查請求	未謝求	球項の数 6	OL	(全 5 頁)	最終頁に続く

(21)出顧番号 特顧平10-204830

(22)出顧日 平成10年7月21日(1998.7.21)

(71)出願人 000134051

株式会社ディスコ

東京都大田区東糀谷2丁目14番3号

(72)発明者 稲葉 和徳

東京都大田区東縣谷2-14-3 株式会社

ディスコ内

(74)代理人 100063174

弁理士 佐々木 功 (外1名)

Fターム(参考) 3B116 AA03 AB04 AB34 BB22 BB45

0003

3B201 AA03 AB34 AB42 BB22 BB92

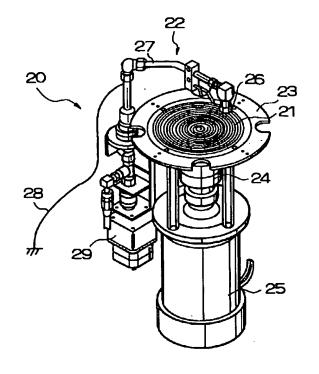
BB98 CC12

(54) 【発明の名称】 スピンナー洗浄装置及びダイシング装置

(57)【要約】

【課題】 回転可能なスピンナーテーブルに保持された 被洗浄物に対して洗浄水を噴射することにより被洗浄物 を洗浄するスピンナー洗浄装置において、洗浄時に静電 気が発生するのを防止することにより被洗浄物に静電気 が帯電するのを防止する。

【解決手段】 被加工物を保持し回転可能なスピンナーテーブルと、該スピンナーテーブルに保持された被洗浄物に洗浄水を噴射する洗浄水噴射手段とから少なくとも構成されるスピンナー洗浄装置において、洗浄水噴射手段をアースに接続して静電気をアースに逃がすようにする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被加工物を保持し回転可能なスピンナー テーブルと、該スピンナーテーブルに保持された被洗浄 物に洗浄水を噴射する洗浄水噴射手段とから少なくとも 構成されるスピンナー洗浄装置であって、

該洗浄水噴射手段はアースに接続されているスピンナー 洗浄装置。

【請求項2】 被洗浄物を保持したスピンナーテーブル が所要速度で回転し、該スピンナーテーブルの回転に伴 って回転する被洗浄物に対して該洗浄水噴射手段が揺動 10 しながら洗浄水を噴射する請求項1に記載のスピンナー 洗浄装置。

【請求項3】 洗浄水噴射手段は、洗浄が終了した後に 洗浄水の噴射を止め、スピンナーテーブルは高速回転し てその遠心力によって被洗浄物に付着している洗浄水を 飛ばしてスピン乾燥する請求項1または2に記載のスピ ンナー洗浄装置。

【請求項4】 洗浄水噴射手段の所要位置には気体噴射 手段が配設されており、スピン乾燥の際は該気体噴射手 段から気体を噴射する請求項3に記載のスピンナー洗浄 20 装置。

【請求項5】 被洗浄物は半導体ウェーハであり、洗浄 水は純水である請求項1乃至4に記載のスピンナー洗浄 装置。

【請求項6】 半導体ウェーハをダイシングするダイシ ング装置であって、請求項1乃至5に記載のスピンナー 洗浄装置を搭載し、該スピンナー洗浄装置によってダイ シング後の半導体ウェーハを洗浄するダイシング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、回転可能なスピン ナーテーブルに保持された被洗浄物に対して洗浄水を噴 射することにより被洗浄物を洗浄するスピンナー洗浄装 置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】この種のスピンナー洗浄装置は、例え ば、半導体ウェーハをダイシングするダイシング装置に 搭載され、ダイシング後の半導体ウェーハに付着した切 削屑を除去する等のために用いられる。

【0003】そして、洗浄の際には被洗浄物を保持した 40 スピンナーテーブルが回転すると共に洗浄水が半導体ウ ェーハに対して噴射されることにより、付着した切削屑 が取り除かれる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、洗浄水 の流通経路、特に噴射口付近において洗浄水と流通経路 の内壁との間の摩擦によって静電気が発生すると、その 静電気を帯びた洗浄水が半導体ウェーハに噴射されるこ とにより半導体ウェーハにも静電気が帯電し、半導体ウ ェーハの品質を低下させることがある。特に、洗浄水と 50 ハWは保持テープTを介してフレームFに保持されてカ

して純水を用いた場合にはこの現象が発生しやすい。ま た、このような現象は、半導体ウェーハを洗浄する場合 だけでなく、他の被洗浄物に対しても同様に起こりう

【0005】従って、被洗浄物に対して洗浄水を噴出し て洗浄を行う場合においては、静電気の発生を防止する ことにより被洗浄物に静電気が帯電するのを防止するこ とに解決すべき課題を有している。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の具体的手段として本発明は、被加工物を保持し回転可 能なスピンナーテーブルと、該スピンナーテーブルに保 持された被洗浄物に洗浄水を噴射する洗浄水噴射手段と から少なくとも構成されるスピンナー洗浄装置であっ て、洗浄水噴射手段はアースに接続されているスピンナ 一洗浄装置を提供する。

【0007】そして、被洗浄物を保持したスピンナーテ ーブルが所要速度で回転し、スピンナーテーブルの回転 に伴って回転する被洗浄物に対して洗浄水噴射手段が揺 動しながら洗浄水を噴射すること、洗浄水噴射手段は、 洗浄が終了した後に洗浄水の噴射を止め、スピンナーテ ーブルは高速回転してその遠心力によって被洗浄物に付 着している洗浄水を飛ばしてスピン乾燥すること、洗浄 水噴射手段の所要位置には気体噴射手段が配設されてお り、スピン乾燥の際は気体噴射手段から気体を噴射する こと、被洗浄物は半導体ウェーハであり、洗浄水は純水 であることを付加的要件とするものである。

【0008】このように構成されるスピンナー洗浄装置 においては、洗浄水噴射手段がアースに接続されてお 30 り、洗浄水噴射手段とそこを流通する洗浄水との摩擦に よって静電気が発生したとしてもその静電気をアースへ 逃がすことができるため、噴射される洗浄水に帯電する 静電気が大幅に低減され、被洗浄物に静電気がほとんど

【0009】また、本発明は、半導体ウェーハをダイシ ングするダイシング装置であって、上記のスピンナー洗 浄装置を搭載し、該スピンナー洗浄装置によってダイシ ング後の半導体ウェーハを洗浄するダイシング装置をも 提供する。

【0010】このようなダイシング装置によれば、洗浄 水に帯電する静電気が大幅に低減されて、半導体ウェー ハに静電気がほとんど帯電しない。

[0011]

帯電しない。

【発明の実施の形態】本発明に係るスピンナー洗浄装置 は、例えば図1に示すダイシング装置10に搭載されて 半導体ウェーハの洗浄を行う。

【0012】まず、図1のダイシング装置10の構成及 び動作について説明する。このダイシング装置10を用 いて半導体ウェーハWを切削するときは、半導体ウェー

セット11に複数段に重ねて収納される。

【0013】フレームFに保持された半導体ウェーハWは、搬出入手段12によってカセット11から搬出され、仮置き領域13に載置され、第一の搬送手段14に吸着されて第一の搬送手段14が旋回動することによりチャックテーブル15に搬送されて載置され、吸引保持される。

【0014】半導体ウェーハWがチャックテーブル15 に吸引保持されると、チャックテーブル15がX軸方向 に移動してアライメント手段16の直下に位置付けられ、パターンマッチング等の処理によって切削領域が検出され、切削領域と回転ブレード17とのY軸方向の位置合わせが行われる。こうして位置合わせがなされると、更にチャックテーブル15がX軸方向に移動し、回転ブレード17の作用を受けて切削が行われる。

【0015】切削後は、付着した切削屑等を除去するために、第二の搬送手段18の吸着部19がフレームFを吸着してスピンナー洗浄装置20の直上へ移動させ、保持部21が下降して吸着状態を解除することによりフレームFに保持された半導体ウェーハWがスピンナー洗浄20装置20に搬送される。

【0016】スピンナー洗浄装置20は、図2に示すように、被洗浄物が載置されるスピンナーテーブル21 と、被洗浄物である半導体ウェーハWに対して洗浄水を噴射する洗浄水噴射手段22とから概ね構成される。

【0017】スピンナーテーブル21は、基台23に回転可能に支持されており、下部に設けられた連結部24によってモーター25に接続され、回転する構成となっている。また、スピンナーテーブル21の表面は、例えば同心円状の複数の吸引溝と、それと交差する放射状の30吸引溝とで形成され、図示しない吸引源に連通して半導体ウェーハWを吸引保持することができる。

【0018】洗浄水噴射手段22を図3に拡大して示す。洗浄水噴射手段22の先端には洗浄水が噴射される洗浄水吐出部26が下向きに配設され、ここから半導体ウェーハWに対して洗浄水が噴射される。洗浄水吐出部26から噴射される洗浄水は、洗浄水供給源(図示せず)からノズルアーム27を通って供給される。

【0019】洗浄水吐出部26及びノズルアーム27は、共に導電性の高い材質により形成されている。ノズ 40ルアーム27は例えば金属により形成され、図2に示したように切削装置10が備えている先端が接地されたアース線28に接続されている。また、洗浄水吐出部26は、例えばコバルトを5~7%含有した焼結ダイヤモンドによって形成され、洗浄水との間の摩擦に耐え得る充分な耐摩耗性を有すると共に、高い導電性を確保してい

【0020】ノズルアーム27は、アース線28に接続されているため、アースされている。また、ノズルアーム27は、駆動源29に駆動されて待避位置への旋回動 50

及び揺動可能であり、ノズルアーム27の揺動に伴って 洗浄水吐出部26が揺動する。

【0021】図3に示したように洗浄水吐出部26の近 傍には気体噴射手段30が配設されており、ここからは 被洗浄物に向けてエアーを噴出することができる。

【0022】このように構成されるスピンナー洗浄装置 20を用いて切削後の半導体ウェーハWを洗浄するとき は、半導体ウェーハWをスピンナーテーブル21に載置 する。このとき吸引源から供給される吸引力によって半 導体ウェーハWは吸引保持される。

【0023】そして、スピンナーテーブル21が比較的 低速回転すると共に、洗浄水吐出部26から洗浄水、例 えば純水が噴射されて半導体ウェーハWの表面が洗浄さ れる。またこのとき、必要に応じてノズルアーム27を 左回り、右回り、左回り、・・・・と交互に所要角度回 転させることによって洗浄水噴射手段22全体を揺動さ せて半導体ウェーハWの表面全体に均等に洗浄水を噴射 するようにすることができる。

【0024】洗浄水がノズルアーム27を通過する際、または洗浄水吐出部26を通過する際に洗浄水とノズルアーム27または洗浄水吐出部26の内壁との間の摩擦によって静電気が発生することがある。こうして静電気が発生すると、その静電気は洗浄水に帯電し、その洗浄水が半導体ウェーハWに噴射されると、ひいては半導体ウェーハWにも静電気が帯電して個々のチップの品質を低下させることになる。

【0025】しかし、本発明においてはノズルアーム27及び洗浄水吐出部26が導電性の高い部材により形成されていると共に、ノズルアーム27がアース線に接続されており、洗浄水吐出部26もアースに接続されることになるので、たとえ静電気が発生したとしてもその大半をアースに逃がすことができる。従って、半導体ウェーハWに静電気が帯電することがほとんどなく、個々のチップの品質を低下させるという問題もほとんど発生しない。

【0026】ノズルアーム27をアースに接続しなかった場合と本実施の形態のようにノズルアーム27をアースに接続した場合について、洗浄水を純水、吐出圧を100[kgf/cm²]としてそれぞれ洗浄水吐出部26における静電気を5回ずつ測定したところ、アースに接続しなかった場合の静電気は平均で3.85[kV]となり、アースに接続した場合は平均で0.33[kV]となった。この測定結果より、ノズルアーム27をアースに接続することによって、洗浄水吐出部26における静電気が十分の一以下に低減されたことがわかる。【0027】なお、本実施の形態においてはノズルアーム27をアースに接続する構成としたが、必ずしもこれに限定されるものではなく、洗浄水噴射手段22の任意の一部がアースに接続されていればよい。

50 【0028】このようにして洗浄水の噴射により半導体

5

ウェーハWに付着した切削屑が除去された後は、洗浄水の噴射を止め、スピンナーテーブル21を高速回転させると、その回転による遠心力によって切削屑及び洗浄水が飛ばされてスピン乾燥される。このとき必要に応じて、気体噴射手段30からエアーを吹き付けることにより、より効果的にスピン乾燥を行うことができる。

【0029】スピンナー洗浄装置20による洗浄の終了後は、フレームFが第一の搬送手段14に吸着されて仮置き領域13に搬送され、搬出入手段12によってカセット11の収納される。

[0030]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るスピンナー洗浄装置においては、洗浄水噴射手段がアースに接続されており、洗浄水噴射手段とそこを流通する洗浄水との摩擦によって静電気が発生したとしてもその静電気をアースへ逃がすことができる。従って、噴射される洗浄水に帯電する静電気が大幅に低減され、被洗浄物に静電気がほとんど帯電しないため、被洗浄物の品質の低下を招くことがなくなる。

【0031】また、本発明に係るダイシング装置によれ 20 …アース線 ば、洗浄水に帯電する静電気が大幅に低減されて、半導 29……駆! 体ウェーハに静電気がほとんど帯電しないため、品質の W……半導 良好な半導体チップを製造することができる。 ーム

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るダイシング装置を示す斜視図である。

【図2】本発明に係るスピンナー洗浄装置を示す斜視図 である。

【図3】同スピンナー洗浄装置を構成する洗浄水噴射手段を拡大して示した斜視図である。

【符号の説明】

10……ダイシング装置 11……カセット 12…… 10 搬出入手段

13……仮置き領域 14……第一の搬送手段 15… …チャックテーブル

16……アライメント手段 17……回転プレード 1 8……第二の搬送手段

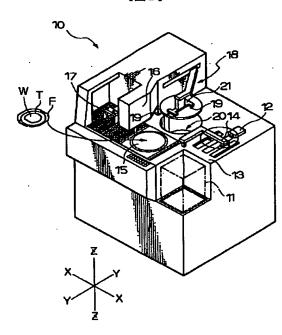
19……吸着部 20……スピンナー洗浄装置 21… …スピンナーテーブル

26……洗浄水吐出部 27……ノズルアーム 28…

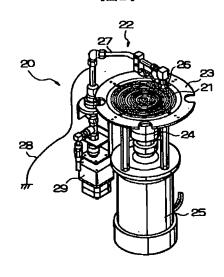
29……駆動源 30……気体噴射手段

W······半導体ウェーハ T······保持テープ F·····フレーム

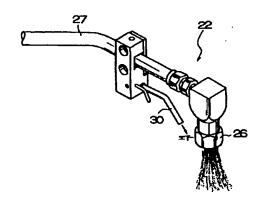
【図1】



【図2】







フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷ 識別記号

FΙ

テーマコード(参考

HO1L 21/301

HO1L 21/78

Р